製品カタログ

RFパワートランジスタ

RFパワートランジスタは、バイアスとRFドライブ信号を増幅段の出力電力に変換する能動半導体デバイスです。送信チェーン、パルスまたは連続波の電力モジュール、産業用RF装置、高電力試験装置で使われます。



製品: 11

改訂: 9 · 改訂日: 2026-11-11



LCT-5700-7100-PS51T

5700–7100 MHz GaN 内部整合型パワートランジスタ — PSAT 51 dBm (標準値)

5700–7100 MHz; PSAT 51 dBm (標準値); 電力利得 11 dB (標準値); PAE 45 % (標準値).

動作周波数: 記号: f; 最小値: 5700; 最大値: 7100; 値: 5700–7100; 単位: MHz

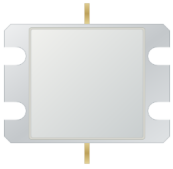
飽和出力電力: 最小値: 50.5; 代表値: 51; 単位: dBm

電力利得: 最小値: 10.5; 代表値: 11; 単位: dB

電力付加効率: 最小値: 40; 代表値: 45; 単位: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 40 dBm; D = 10%; PW = 100 µs

製品詳細　製品データシート



LCT-2700-3500-PS56p5T

2700–3500 MHz GaN 内部整合型パワートランジスタ — PSAT 56.5 dBm (標準値)

2700–3500 MHz; PSAT 56.5 dBm (標準値); 電力利得 13.5 dB (標準値); PAE 55 % (標準値).

動作周波数: 記号: f; 最小値: 2700; 最大値: 3500; 値: 2700–3500; 単位: MHz

飽和出力電力: 最小値: 56; 代表値: 56.5; 単位: dBm

電力利得: 最小値: 13; 代表値: 13.5; 単位: dB

電力付加効率: 最小値: 50; 代表値: 55; 単位: %

TA = +25 °C; VDS = 44 V; VGS ∈ [-4, -2] V; IDS = (0.2–0.5) IDSS; PW = 300 µs; D = 10%

製品詳細　製品データシート



LCT-5300-5900-PS56p5T

5300–5900 MHz GaN 内部整合型パワートランジスタ — PSAT 56.5 dBm (標準値)

5300–5900 MHz; PSAT 56.5 dBm (標準値); 電力利得 12.5 dB (標準値); PAE 45 % (標準値).

動作周波数: 記号: f; 最小値: 5300; 最大値: 5900; 値: 5300–5900; 単位: MHz

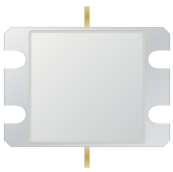
飽和出力電力: 最小値: 56; 代表値: 56.5; 単位: dBm

電力利得: 最小値: 12; 代表値: 12.5; 単位: dB

電力付加効率: 最小値: 40; 代表値: 45; 単位: %

TA = +25 °C; VDS = 40 V; VGS ∈ [-4, -2] V; IDS = (0.2–0.5) IDSS; PW = 10 µs; D = 1%

製品詳細　製品データシート



LCT-2700-3900-PS48p5T

2700–3900 MHz GaN 内部整合型パワートランジスタ — PSAT 48.5 dBm (標準値)

2700–3900 MHz; PSAT 48.5 dBm (標準値); 電力利得 12.5 dB (標準値); PAE 50 % (標準値).

動作周波数: 記号: f; 最小値: 2700; 最大値: 3900; 値: 2700–3900; 単位: MHz

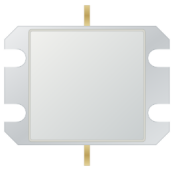
飽和出力電力: 最小値: 48; 代表値: 48.5; 単位: dBm

電力利得: 最小値: 12; 代表値: 12.5; 単位: dB

電力付加効率: 最小値: 45; 代表値: 50; 単位: %

TA = +25 °C; VDS = 24–28 V; VGS ∈ [-4, -2] V; IDS = (0.2–0.5) IDSS

製品詳細　製品データシート



LCT-2700-3500-PS53p5T

2700–3500 MHz GaN 内部整合型パワートランジスタ — PSAT 53.5 dBm (標準値)

2700–3500 MHz; PSAT 53.5 dBm (標準値); 電力利得 13.5 dB (標準値); PAE 65 % (標準値).

動作周波数: 記号: f; 最小値: 2700; 最大値: 3500; 値: 2700–3500; 単位: MHz

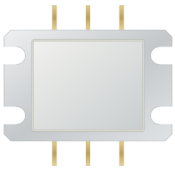
飽和出力電力: 最小値: 53; 代表値: 53.5; 単位: dBm

電力利得: 最小値: 13; 代表値: 13.5; 単位: dB

電力付加効率: 最小値: 60; 代表値: 65; 単位: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-4, -2] V; Pin = 40 dBm; D = 10%; PW = 100 µs

製品詳細　製品データシート



LCT-2300-3900-PS50T

2300–3900 MHz GaN 内部整合型パワートランジスタ — PSAT 50 dBm (標準値)

2300–3900 MHz; PSAT 50 dBm (標準値); 電力利得 12 dB (標準値); PAE 50 % (標準値).

動作周波数: 記号: f; 最小値: 2300; 最大値: 3900; 値: 2300–3900; 単位: MHz

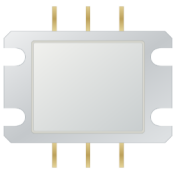
飽和出力電力: 最小値: 49; 代表値: 50; 単位: dBm

電力利得: 最小値: 11; 代表値: 12; 単位: dB

電力付加効率: 最小値: 45; 代表値: 50; 単位: %

TA = +25 °C; VGS ∈ [-4, -2] V; VDS = 24–28 V; IDS = (0.2–0.5) IDSS

製品詳細　製品データシート



LCT-2600-3700-PS49T

2600–3700 MHz GaN 内部整合型パワートランジスタ — PSAT 49 dBm (標準値)

2600–3700 MHz; PSAT 49 dBm (標準値); 電力利得 13 dB (標準値); PAE 50 % (標準値).

動作周波数: 記号: f; 最小値: 2600; 最大値: 3700; 値: 2600–3700; 単位: MHz

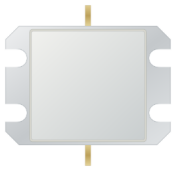
飽和出力電力: 最小値: 48; 代表値: 49; 単位: dBm

電力利得: 最小値: 12; 代表値: 13; 単位: dB

電力付加効率: 最小値: 45; 代表値: 50; 単位: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.2] V; Pin = 36 dBm; CW

製品詳細　製品データシート



LCT-8500-9600-PS51T

8500–9600 MHz GaN 内部整合型パワートランジスタ — PSAT 51 dBm (標準値)

8500–9600 MHz; PSAT 51 dBm (標準値); 電力利得 9 dB (標準値); PAE 38 % (標準値).

動作周波数: 記号: f; 最小値: 8500; 最大値: 9600; 値: 8500–9600; 単位: MHz

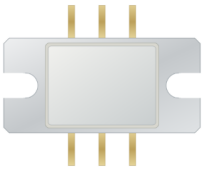
飽和出力電力: 最小値: 50; 代表値: 51; 単位: dBm

電力利得: 最小値: 8; 代表値: 9; 単位: dB

電力付加効率: 代表値: 38; 単位: %

Vd = +28 V; Vg = -3 V; PW = 100 µs; D = 10%; Pin = 42 dBm

製品詳細　製品データシート



LCT-2000-6000-PO45p51T

2000–6000 MHz GaN 内部整合型パワートランジスタ — Pout 45.51 dBm @ 6000 MHz (標準値)

2000–6000 MHz; 参考出力電力 45.51 dBm (標準値); 電力利得 19.51 dB (標準値); ドレイン効率 39.82 % (標準値) @ 6000 MHz.

動作周波数: 記号: f; 最小値: 2000; 最大値: 6000; 値: 2000–6000; 単位: MHz

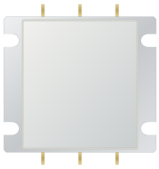
参考出力電力: 代表値: 45.51; 単位: dBm; 注記: f = 6000 MHz

電力利得: 代表値: 19.51; 単位: dB; 注記: f = 6000 MHz

ドレイン効率: 記号: ηD; 代表値: 39.82; 単位: %; 注記: f = 6000 MHz

TA = +25 °C; VDS = 28 V; IDQ = 1.3 A; CW; f = 6000 MHz; Pin = 26 dBm

製品詳細　製品データシート



LCT-700-6200-PS49T

700–6200 MHz GaN 内部整合型パワートランジスタ — PSAT 49 dBm @ 6000 MHz (標準値)

700–6200 MHz; 飽和出力電力 49 dBm (標準値); 電力利得 7 dB (標準値); ドレイン効率 35 % (標準値) @ 6000 MHz.

動作周波数: 記号: f; 最小値: 700; 最大値: 6200; 値: 700–6200; 単位: MHz

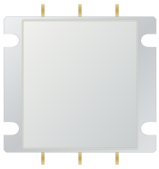
飽和出力電力: 記号: Psat; 代表値: 49; 単位: dBm; 注記: f = 6000 MHz

電力利得: 代表値: 7; 単位: dB; 注記: f = 6000 MHz

ドレイン効率: 記号: ηD; 代表値: 35; 単位: %; 注記: f = 6000 MHz

TA = +25 °C; VDS = 28 V; IDQ = 1 A; CW; f = 6000 MHz

製品詳細　製品データシート



LCT-2000-6200-PO50p1T

2000–6200 MHz GaN 内部整合型パワートランジスタ — Pout 50.1 dBm @ 6000 MHz (標準値)

2000–6200 MHz; 参考出力電力 50.1 dBm (標準値); 電力利得 8.6 dB (標準値); ドレイン効率 52.4 % (標準値) @ 6000 MHz.

動作周波数: 記号: f; 最小値: 2000; 最大値: 6200; 値: 2000–6200; 単位: MHz

参考出力電力: 代表値: 50.1; 単位: dBm; 注記: f = 6000 MHz

電力利得: 代表値: 8.6; 単位: dB; 注記: f = 6000 MHz

ドレイン効率: 記号: ηD; 代表値: 52.4; 単位: %; 注記: f = 6000 MHz

TA = +25 °C; VDS = 28 V; IDQ = 0.5 A; CW; f = 6000 MHz; Pin = 41.5 dBm

製品詳細　製品データシート

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確

認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。